



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207489917 U

(45)授权公告日 2018.06.12

(21)申请号 201721632015.5

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

(22)申请日 2017.11.29

(73)专利权人 江苏集萃有机光电技术研究所有  
限公司

地址 215000 江苏省苏州市吴江区黎里镇  
汾湖大道1198号

(72)发明人 梁舰 丁磊 祝晓钊 冯敏强  
廖良生

(74)专利代理机构 北京超凡志成知识产权代理  
事务所(普通合伙) 11371

代理人 唐维虎

(51)Int.Cl.

H01L 51/50(2006.01)

H01L 51/52(2006.01)

H01L 27/32(2006.01)

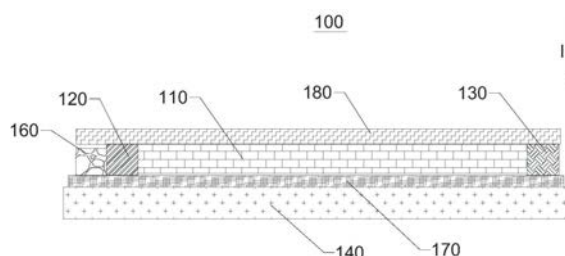
权利要求书1页 说明书7页 附图4页

(54)实用新型名称

OLED器件及像素结构

(57)摘要

本实用新型实施例提供一种OLED器件及像素结构。所述OLED器件包括发光单元、第一电极及第二电极。所述第一电极设置在所述发光单元的第一边缘,所述第二电极设置在所述发光单元的第二边缘,以使所述OLED器件光线从所述第一电极和第二电极之间的发光单元发射出来。



1. 一种OLED器件,其特征在于,所述OLED器件包括发光单元、第一电极及第二电极;  
所述第一电极设置在所述发光单元的第一边缘,所述第二电极设置在所述发光单元的与所述第一边缘相对的第二边缘,以使所述OLED器件光线从所述第一电极和第二电极之间的发光单元发射。
2. 如权利要求1所述的OLED器件,其特征在于,所述第一电极与第二电极之间的距离在50nm-1000nm之间。
3. 如权利要求1所述的OLED器件,其特征在于,所述发光单元呈条形或曲线形。
4. 如权利要求3所述的OLED器件,其特征在于,所述发光单元呈S型或多个S型部分首尾连接而成的形状,所述第一电极与第二电极为与所述发光单元对应的交错设置的梳型电极。
5. 如权利要求3所述的OLED器件,其特征在于,所述发光单元呈螺旋形,每一层发光单元对应的第一电极及第二电极也形成与发光单元对应的螺旋形,所述OLED器件还包括螺旋形绝缘层,螺旋形绝缘层沿着所述OLED器件内圈环绕设置,以将内圈的电极缠绕至外圈电极外侧时将该内圈的电极与外圈的电极隔开。
6. 如权利要求1所述的OLED器件,其特征在于,所述OLED器件还包括反射层,所述反射层设置在所述OLED器件远离出光面的一侧,所述反射层是金属反射层或分布式布拉格反射层。
7. 如权利要求1所述的OLED器件,其特征在于,所述OLED器件还包括封装层,所述封装层设置在发光单元表面;或,  
所述OLED器件还包括封装扩散层,所述封装扩散层设置在发光单元、第一电极及第二电极的表面。
8. 一种像素结构,其特征在于,所述像素结构包括多个权利要求1-7任意一项所述的OLED器件;所述OLED器件的第一电极分别与薄膜晶体管连接,以接收通过所述薄膜晶体管传输的驱动信号,控制对应的发光单元发光。
9. 如权利要求8所述的像素结构,其特征在于,所述像素结构的多个OLED器件叠置设置。
10. 如权利要求8所述的像素结构,其特征在于,所述像素结构还包括扩散层,所述扩散层设置在所述OLED器件的靠近出光面一侧。

## OLED器件及像素结构

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及微电子及光电半导体领域,具体而言,涉及一种OLED器件及像素结构。

### 背景技术

[0002] 现有的OLED器件都是采用电极层与有机层重叠的结构,OLED器件的光线需穿透至少一层透明电极才能发射出来,因此现有OLED器件结构对电极材料的选取通常限于ITO、IZO等金属氧化物透明电极,这类电极与有机材料的HOMO及LUMO能级匹配性不是很好,需要在电极与有机层的界面处修饰载流子的注入层,增加器件的制备工艺,而且金属氧化物透明电极通常性脆而延展性不足,会影响面板的弯折性能。

### 实用新型内容

[0003] 有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种OLED器件及像素结构,将OLED器件的出光方向和器件内电流的流动方向进行分离,从而OLED器件发射的光线不必穿过电极层即可射出,不再依赖透明电极,从而扩大了电极材料可选范围,因此本实用新型所采用的器件结构可实现ITO-free,也可用于实现柔性显示或透明显示技术。

[0004] 本实用新型实施例提供的一种OLED器件,所述OLED器件包括发光单元、第一电极及第二电极;

[0005] 所述第一电极设置在所述发光单元的第一边缘,所述第二电极设置在所述发光单元的与所述第一边缘相对的第二边缘,以使所述OLED器件光线从所述第一电极和第二电极之间的发光单元发射。

[0006] 优选地,第一电极与第二电极之间的距离在50nm-1000nm之间。

[0007] 优选地,第一电极与第二电极之间的距离在100nm-300nm之间。

[0008] 优选地,所述第一电极和第二电极高度在50nm-2000nm之间。

[0009] 优选地,所述第一电极和第二电极高度在200nm-500nm之间。

[0010] 优选地,所述第一电极和第二电极高度与第一电极和第二电极之间的距离的比值在1:1至3:1之间。

[0011] 优选地,第一电极所选材料为金、铂、铜、钨、钼、镍、硅、ITO及石墨烯中任意一种或其组合形成的复合电极。

[0012] 优选地,第二电极所选材料为铝、镁、银、硅及石墨烯中任意一种或其组合形成的复合电极。

[0013] 本实施例中透明电极对于OLED器件不再是必要条件,因此可以降低对ITO等透明电极的依赖,降低对稀有元素In的需求,可以挖掘电极与有机层界面处更有效的注入层材料,提高载流子的注入效率,以改善器件性能。

[0014] 优选地,所述发光单元呈条形或曲线形。

[0015] 通过将所述发光单元制作成条形曲线,或进行弯折,可以填充于任意几何图形内,

从而增大发光单元的面积,进而提升发光单元的整体亮度。

[0016] 优选地,所述发光单元呈S型或多个S型部分首尾连接而成的形状。

[0017] 优选地,所述第一电极与第二电极为与所述发光单元对应的交错设置的梳型电极。

[0018] 优选地,所述发光单元呈螺旋形,每一层发光单元对应的第一电极及第二电极也形成与发光单元对应的螺旋形,所述OLED器件还包括螺旋形绝缘层,螺旋形绝缘层沿着所述OLED器件内圈环绕设置,以将内圈的电极缠绕至外圈电极外侧时将该内圈的电极与外圈的电极隔开。

[0019] 优选地,所述OLED器件还包括螺旋形绝缘层,螺旋形绝缘层沿着所述OLED器件内圈环绕设置,以将内圈的电极缠绕至外圈电极外侧时将该内圈的电极与外圈的电极隔开。

[0020] 优选地,所述OLED器件还包括反射层,所述反射层设置在所述OLED器件远离出光面的一侧,所述反射层是金属反射层或分布式布拉格反射层。

[0021] 优选地,所述OLED器件还包括封装层,所述封装层设置在发光单元表面;或,

[0022] 所述OLED器件还包括封装扩散层,所述封装扩散层设置在发光单元、第一电极及第二电极的表面。

[0023] 优选地,所述第一电极与第二电极的高度高于所述发光单元的高度,以使封装层或封装扩散层覆盖在所述第一电极、第二电极及发光单元形成凹陷结构。

[0024] 本实用新型实施例还提供一种像素结构,所述像素结构包括多个上述的OLED器件;所述OLED器件的第一电极分别与薄膜晶体管连接,以接收通过所述薄膜晶体管传输的驱动信号,控制对应的发光单元发光。

[0025] 优选地,所述像素结构的多个OLED器件叠置设置。

[0026] 优选地,所述像素结构的多个OLED器件并列设置。

[0027] 通过将多个OLED器件叠置设置可以缩小像素结构的尺寸,也能够提高分辨率;通过将多个OLED器件并列设置可以防止不同的OLED器件之间相互影响。

[0028] 优选地,所述像素结构还包括扩散层,所述扩散层设置在所述OLED器件的靠近出光面一侧。

[0029] 通过设置扩散层可以使像素结构的显示效果更佳的均匀。

[0030] 优选地,所述像素结构还包括封装层,所述封装层设置在发光单元与所述扩散层之间。

[0031] 与现有技术相比,本实用新型实施例的OLED器件及像素结构,通过将所述第一电极和第二电极设置在所述发光单元的两边缘,使OLED器件光显示不穿过所述第一电极和第二电极,从而对第一电极和第二电极的材料的选择可以不受限制,第一电极和第二电极可以选择透明电极也可以选择非透明电极,第一电极和第二电极都不会挡住所述发光单元的光。

[0032] 为使本实用新型的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附图,作详细说明如下。

## 附图说明

[0033] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用

的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0034] 图1为本实用新型较佳实施例提供的OLED器件的结构示意图。

[0035] 图2为本实用新型另一较佳实施例提供的OLED器件的结构示意图。

[0036] 图3为本实用新型较佳实施例提供的OLED器件的另一角度的结构示意图。

[0037] 图4为本实用新型较佳实施例提供的OLED器件的再一角度的结构示意图。

[0038] 图5是本实用新型较佳实施例提供的像素结构的结构示意图。

[0039] 图标:10-像素结构;100-OLED器件;110-发光单元;112-蓝色发光单元;114-绿色发光单元;116-红色发光单元;120-第一电极;130-第二电极;140-基板;150-绝缘层;152-屏蔽层;160-薄膜晶体管;162-第一薄膜晶体管;164-第二薄膜晶体管;166-第三薄膜晶体管;170-反射层;180-封装层;181-封装扩散层;190-扩散层。

### 具体实施方式

[0040] 下面将结合本实用新型实施例中附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0041] 应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。同时,在本实用新型的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0042] 本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是所述实用新型产品使用时惯常拜访的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能解释为本实用新型的限制。

[0043] 本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接连接,也可以是通过中间媒介间接连接,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0044] 图1为本实用新型较佳实施例提供的OLED器件100的结构示意图。如图1所示,所述OLED器件100包括:所述OLED器件100包括发光单元110、第一电极120及第二电极130。所述第一电极120设置在所述发光单元110的第一边缘,所述第二电极130设置在所述发光单元110的与所述第一边缘相对的第二边缘,以使所述OLED器件100光显示从所述第一电极120

和第二电极130之间的发光单元110穿过显示。

[0045] 本实施例中,所述发光单元110制作在一基板140上。

[0046] 本实施例中,第一电极120制作在所述基板140上,与所述发光单元110的第一边缘接触;所述第二电极130也制作在所述基板140上,与所述发光单元110的第二边缘接触。本实施例中,所述第一电极120、发光单元110以及第二电极130制作在同一平面上。

[0047] 通过将所述第一电极120、发光单元110以及第二电极130制作在同一平面上,可以使OLED器件100的显示从第一电极120及第二电极130之间的区域显示,第一电极120及第二电极130的不会挡住OLED器件100的光,因此,本实施例中的OLED器件100的第一电极120和第二电极130的选材没有透光率的要求,可以不依赖ITO、IZO等透明电极,以使第二电极130和第二电极130可以选择透明材质也可以选择非透明材质。

[0048] 本实施例中,第一电极120和第二电极130可以根据发光单元110的有机材料的能带特征选择第一电极120和第二电极130的材料进行能级匹配。

[0049] 在一种实施方式中,所述第一电极120作为驱动电极,可以选择高功函数材料,例如,第一电极120选择具有高于4eV的功函数的材料。例如,第一电极120的材料包括导电金属氧化物,例如,金、铂、铜、钨、钼、镍、硅、ITO及石墨烯中任意一种或其组合形成的复合电极。

[0050] 在一种实施方式中,所述第一电极120作为阴极,可以选择低功函数材料,例如,第二电极130选择具有低于4eV的功函数的材料。本实施例中的第二电极130可选材料为铝、镁、银、硅及石墨烯中任意一种或其组合形成的复合电极。

[0051] 例如,ITO中的In是稀土元素,储量少,价格高,因此,需要考虑制作成本时,所述第一电极120和第二电极130可以选择除ITO以外的其它材质制作电极。再例如,由于ITO是脆性的,因此需要制作柔性OLED器件100时,所述第一电极120和第二电极130可以选择除ITO以外的其它材质制作电极。

[0052] 本实施例中,所述OLED器件100还包括封装层180,所述封装层180设置在发光单元110表面。

[0053] 本实施例中,如图2所示,所述OLED器件还包括封装扩散层181,所述封装扩散层181设置在发光单元110、第一电极120及第二电极130的表面。本实施例中,如图2所示,所述第一电极120和第二电极130的高度可以比所述发光单元110的高度高,所述封装扩散层181内嵌在所述第一电极120、发光单元110与第二电极130形成的凹槽中。在一种实施方式中,所述封装扩散层181通过沉积的方式制作在所述发光单元110、第一电极120及第二电极130的表面。本实施例中,所述封装扩散层181可采用光折射率大于所述发光单元110所使用的材料。通过上述凹陷的结构及封装扩散层181材料的选取得到对应的折射率有利于OLED器件的光取出。进一步地,所述封装扩散层181中还可以包括光散射颗粒,以使所述封装扩散层181有光扩散的效果,以实现封装层和扩散层二合一的效果。将封装层和扩散层二合一的设计方式可以使制作工艺更加简单。

[0054] 本实施例中,请再次参阅图2,所述第一电极120与第二电极130的高度高于所述发光单元110的高度,以使封装层或封装扩散层覆盖在所述第一电极120、第二电极130及发光单元110形成凹陷结构。通过所述凹槽结构可以提高OLED器件的出光效率和可视角度。

[0055] 本实用新型实施例的OLED器件100,通过将所述第一电极120和第二电极130设置

在所述发光单元110的两边缘,使OLED器件100光显示不穿过所述第一电极120和第二电极130,从而对第一电极120和第二电极130的材料的选择可以不受限制,第一电极120和第二电极130可以选择透明电极也可以选择非透明电极,第一电极120和第二电极130都不会挡住所述发光单元110的光。

[0056] 本实施例中,第一电极120与第二电极130的距离在50nm-1000nm之间,例如,所述第一电极120与第二电极130的距离可以是50nm、100nm、150nm、300nm、1000nm等。本实施例中,所述第一电极120与第二电极130的距离可以根据所述发光单元110中的有机材料的载流子迁移率进行调整。例如,所述发光单元110中的有机材料的载流子迁移率越高,第一电极120与第二电极130的距离越大;所述发光单元110中的有机材料的载流子迁移率越低,第一电极120与第二电极130的距离越小。

[0057] 本实施例中,所述第一电极120和第二电极130高度可以在50nm-2000nm之间,优选的在200nm-500nm。例如,所述第一电极120与第二电极130的厚度可以是50nm、100nm、150nm、200nm、300nm、500nm、2000nm等。

[0058] 本实施例中,所述第一电极120和第二电极130高度与第一电极120和第二电极130之间的距离的比值在1:1至3:1之间。第一电极120和第二电极130高度与第一电极120和第二电极130之间的距离的比值高的时候,可能会有光波导效益,可以提高出光量。

[0059] 本实施例中,如图3或4所示,所述发光单元110呈条形或曲线形。其中图3和图4为沿I方向的视角的结构示意图。

[0060] 本实施例中,通过将所述发光单元110设置成条形或曲线型,可以使发光单元110能够更好地填充不同形状的显示屏。

[0061] 在一种实施方式中,如图3所示,所述发光单元110呈S型或弓字型、W型。再或者,所述发光单元呈多个S型部分、弓字型、W型首尾连接而成的形状。所述第一电极120与第二电极130为与所述发光单元110对应的交错设置的梳型电极。本实施例中,所述发光单元110可以是平滑的曲线型,也可以是多条直线型发光单元110连接而成的折线型发光单元110。其中,图3示出的发光单元110是多条直线型发光单元110连接而成的折线型发光单元110。

[0062] 在另一种实施方式中,如图4所示,所述发光单元110呈螺旋形,每一层发光单元110对应的第一电极120及第二电极130也形成与发光单元110对应的螺旋形,所述OLED器件100还包括螺旋形绝缘层,螺旋形绝缘层沿着所述OLED器件100内圈环绕设置,以将内圈的电极缠绕至外圈电极外侧时将该内圈的电极与外圈的电极隔开。

[0063] 本实施例中,发光单元110的材质可以是有机小分子、聚合物及其混合物。所述发光单元110可以通过蒸镀或打印的方式制备。本实用新型实施例并不以发光单元110的制作方式为限。

[0064] 在其它实施例中,所述OLED器件100还可以包括反射层170。

[0065] 制作时,所述反射层170制作在所述基板140上,所述第一电极120、第二电极130及发光单元110制作在所述反射层170上。

[0066] 在一种实施方式中,所述反射层170可以是金属反射。进一步地,所述反射层170为金属反射层170时,所述反射层170与所述第一电极120、发光单元110以及第二电极130所在层之间设置有绝缘层,以避免所述金属反射层170与第一电极120或第二电极130引起短路。所述金属反射层170还可以当作第三电极,用于控制所述发光单元110的电荷密度,调控发

光性能。本实施方式中,所述绝缘层制作在所述反射层170与所述第一电极120、发光单元110以及第二电极130所在层之间。

[0067] 在另一种实施方式中,所述反射层170还可以是分布式布拉格反射层170(distributed Bragg reflection,DBR反射层170)。

[0068] 通过在所述OLED器件100上增加反射层170可以减少OLED器件100光遗漏,使像素单元的显示效果更好。

[0069] 本实用新型实施例还提供一种像素结构10,如图5所示,所述像素结构10包括多个上述实施例提供的OLED器件100;所述OLED器件100的第一电极120分别与薄膜晶体管160连接,以接收通过所述薄膜晶体管160传输的驱动信号,控制对应的发光单元110发光。

[0070] 本实施例中,所述像素结构10包括蓝色发光单元112、绿色发光单元114及红色发光单元116。在一种实施方式中,所述蓝色发光单元112设置在靠近出光面的一层结构中;所述红色发光单元116设置距离出光面最远的一层结构中。由于蓝光是三原色波长最短的光,红光的波长是三原色波长最长的光,因此将蓝光对应的发光单元110设置在距离出光面最近的位置,红光对应的发光单元110设置在距离出光面最远的位置,由于不同发光材料能隙的差异,可以减少发光单元110之间的光吸收,提高像素单元的显示效果。

[0071] 本实施例中,所述像素结构10的多个OLED器件100可以叠置设置,多个OLED器件100也可以并列设置。

[0072] 本实用新型实施例提供的像素结构10,通过将所述像素结构10叠层设置,可以使像素结构10的尺寸更小,分辨率也更高。通过将多个OLED器件100并列设置可以防止相互的OLED器件100之间的相互干扰。本领域的技术人员可以根据需求将所述像素结构10的OLED器件100设置成叠层结构或者并列结构。

[0073] 在一种实施方式中,所述像素结构10可包括三层结构,每层结构中设置一个发光单元110。

[0074] 在另一种实施方式中,所述像素结构10可包括三层结构,第一层结构和第二层结构分别包括一个发光单元110对应的OLED器件100,第三层结构设置有两个发光单元110对应的OLED器件100。

[0075] 在另一种实施方式中,所述像素结构10包括两层结构,第一层结构和第二层结构分别包括两个发光单元110对应的OLED器件100。

[0076] 在另一种实施方式中,所述像素结构10包括两层结构,第一层结构包括一个发光单元110对应的OLED器件100,第二层结构包括两个发光单元110对应的OLED器件100。

[0077] 在另一种实施方式中,所述像素结构10包括四层结构,每层结构中包括一个发光单元110对应的OLED器件100。

[0078] 再一种实施方式中,所述像素结构10包括一层结构,所有的发光单元110对应的OLED器件100并列设置在该层结构中。

[0079] 在一种实施方式中,如图5所示,所述像素结构10的每层结构中的第一电极120分别与一薄膜晶体管160连接。如图5所示,蓝色发光单元112对应的第一电极120连接有第一薄膜晶体管162;绿色发光单元114对应的第一电极120连接有第二薄膜晶体管164;红色发光单元116对应的第一电极120连接有第三薄膜晶体管166。

[0080] 本实施例中,与对应叠置在相邻两层结构中的子像素结构10的第一电极120连接

的薄膜晶体管160设置于像素结构10同一侧,相邻两个所述薄膜晶体管160之间设置有屏蔽层152。

[0081] 在一种实施方式中,如图5所示,所述屏蔽层152制作为相邻两层子像素结构10之间的绝缘层150上与薄膜晶体管160对应位置处,例如,第一薄膜晶体管162与第二薄膜晶体管164之间的绝缘层150上设置有屏蔽层152,第二薄膜晶体管164与第三薄膜晶体管166之间的绝缘层150上设置有屏蔽层152。在另一种实施方式中,所述屏蔽层152内置在所述薄膜晶体管160中,例如,第一薄膜晶体管162上靠近所述第二薄膜晶体管164的一侧设置有屏蔽层152,第二薄膜晶体管164上靠近所述第三薄膜晶体管166的一侧设置有一屏蔽层152。

[0082] 在薄膜晶体管160之间设置屏蔽层152可以有效防止相邻两个薄膜晶体管160之间相互影响。

[0083] 本实施例中,所述像素结构10还包括扩散层190,所述扩散层190设置在所述OLED器件100的靠近出光面一侧。

[0084] 本实施例中,所述像素结构10还包括封装层180,所述封装层180设置在发光单元110与所述扩散层190之间。

[0085] 本实用新型实施例的像素结构10,通过将所述第一电极120和第二电极130设置在所述发光单元110的两边缘,使OLED器件100光显示不穿过所述第一电极120和第二电极130,从而对第一电极120和第二电极130的材料的选择可以不受限制,第一电极120和第二电极130可以选择透明电极也可以选择非透明电极,第一电极120和第二电极130都不会挡住所述发光单元110的光。

[0086] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

[0087] 以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

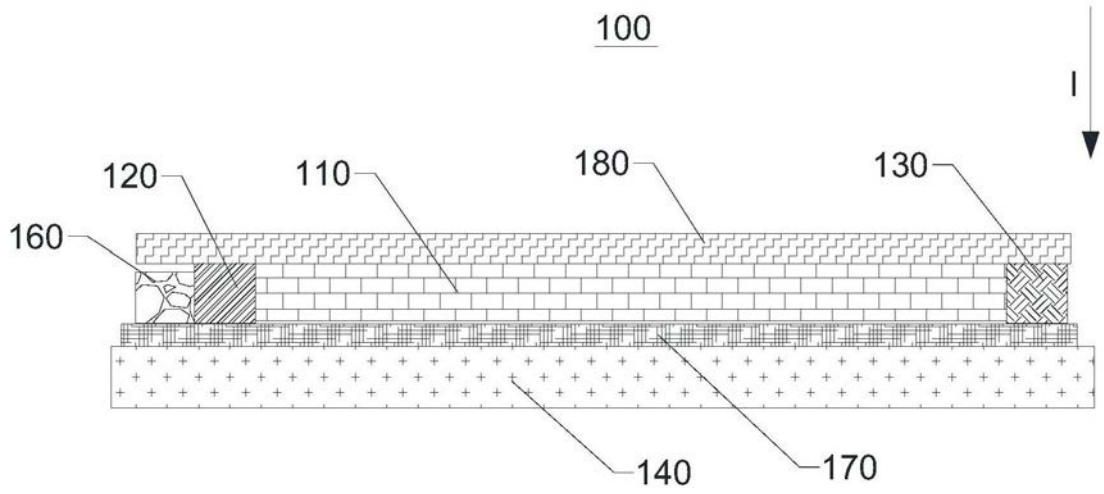


图1

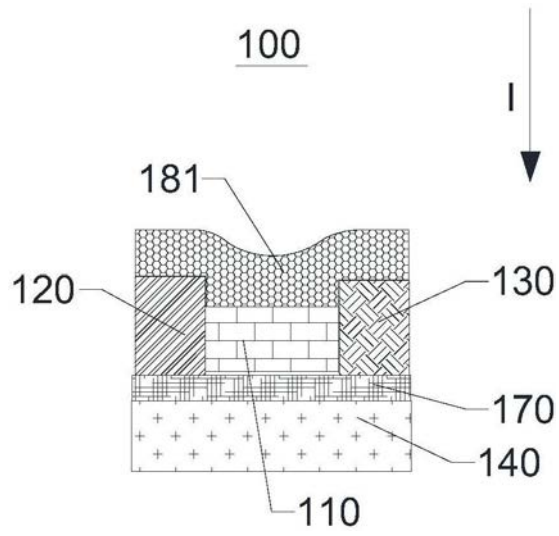


图2

100

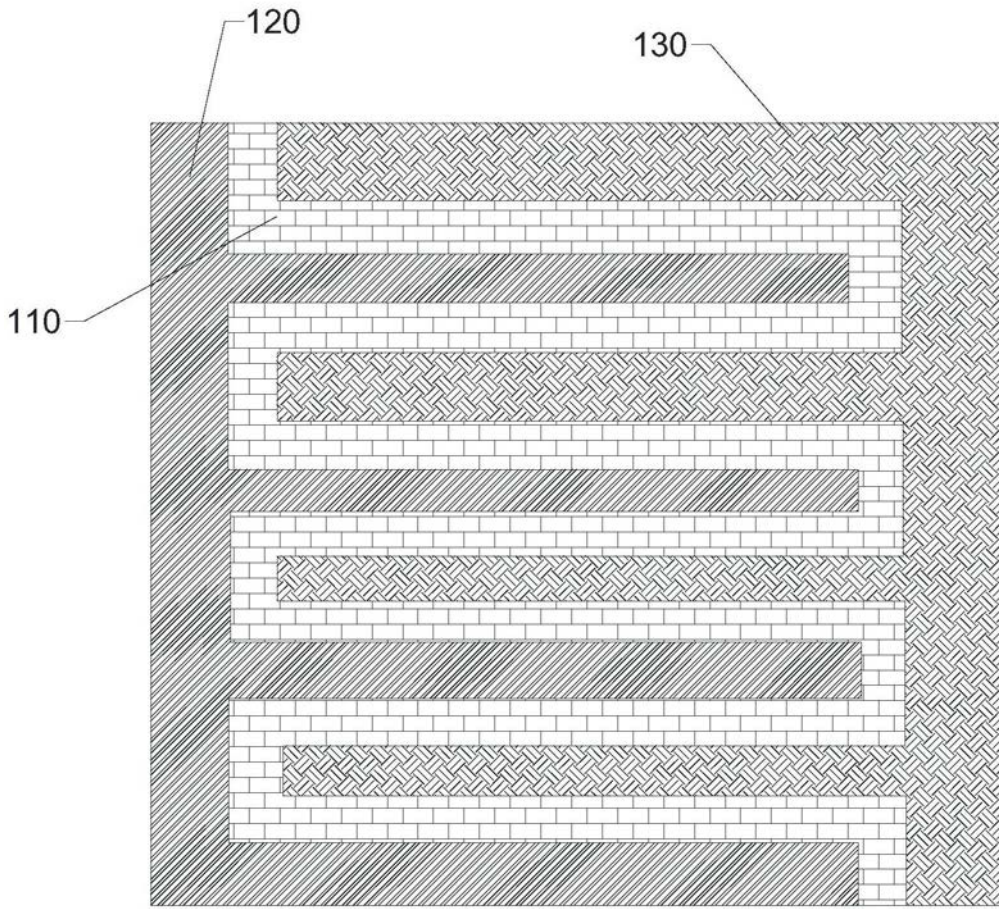


图3

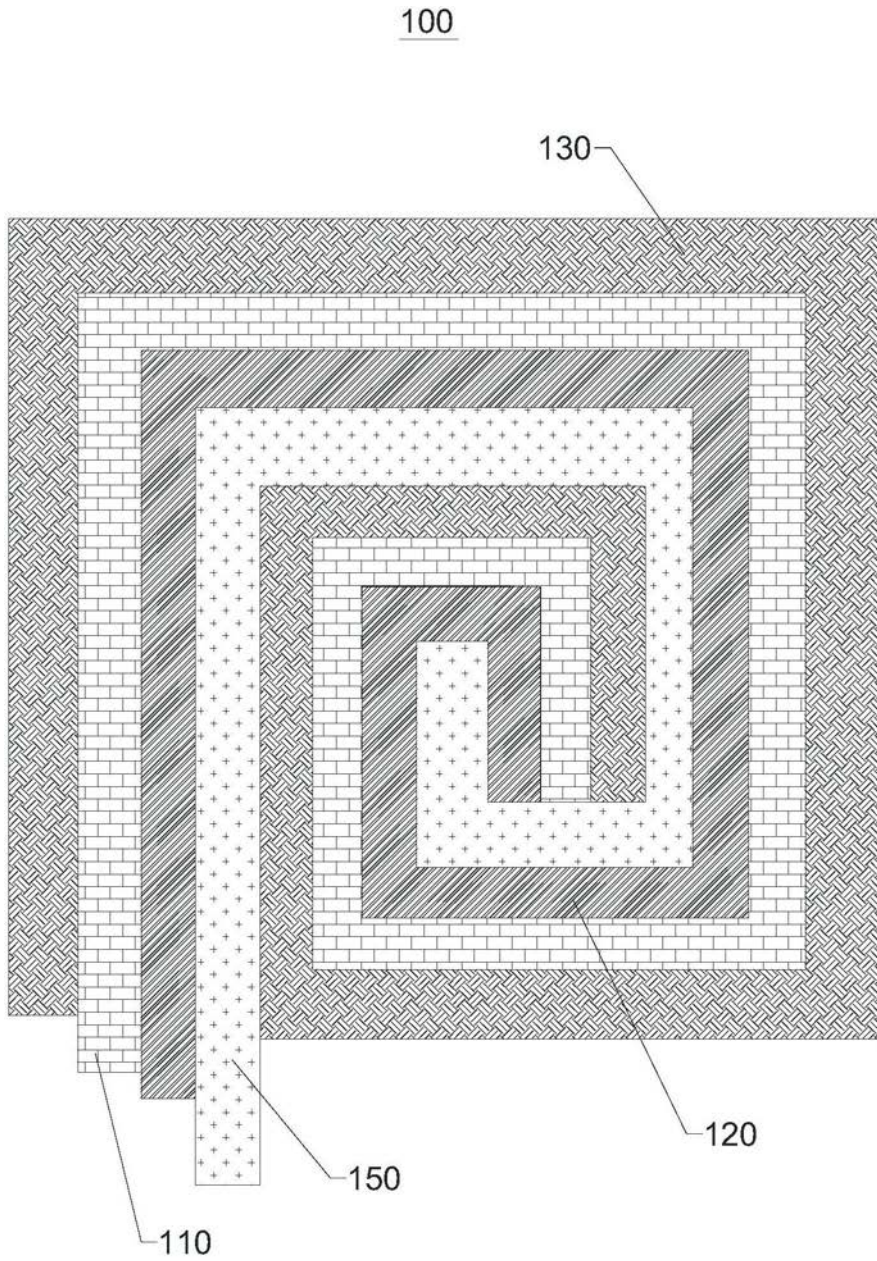


图4

10

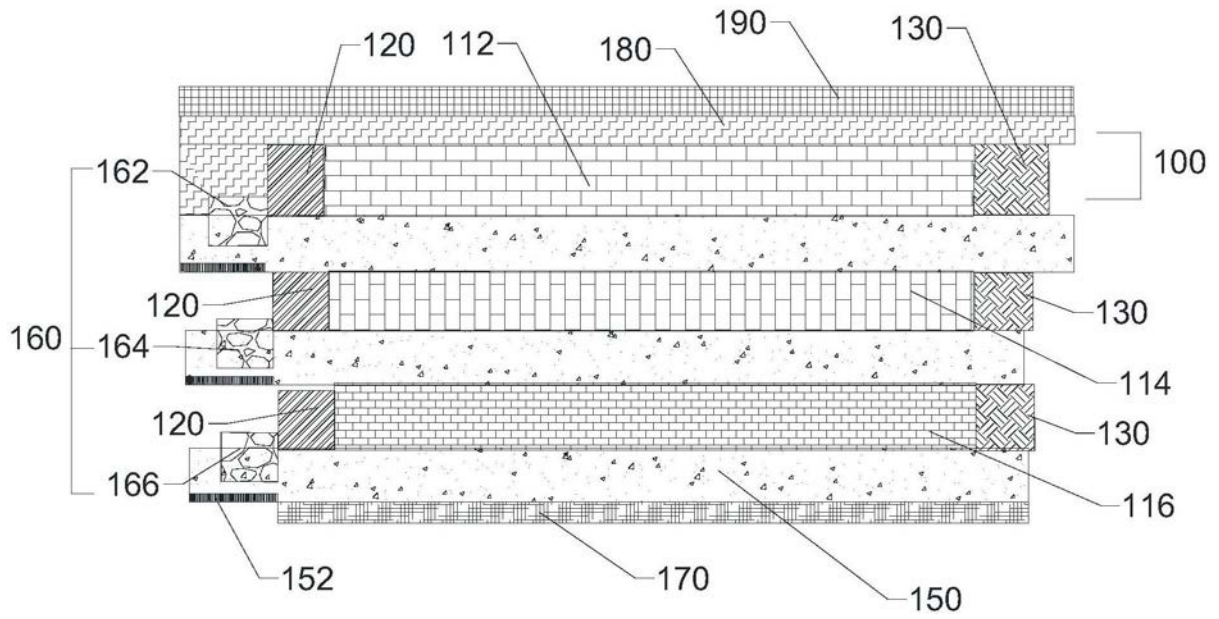


图5

专利名称(译)	OLED器件及像素结构		
公开(公告)号	<a href="#">CN207489917U</a>	公开(公告)日	2018-06-12
申请号	CN201721632015.5	申请日	2017-11-29
[标]申请(专利权)人(译)	江苏集萃有机光电技术研究所有限公司		
申请(专利权)人(译)	江苏集萃有机光电技术研究所有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	江苏集萃有机光电技术研究所有限公司		
[标]发明人	梁舰 丁磊 祝晓钊 冯敏强 廖良生		
发明人	梁舰 丁磊 祝晓钊 冯敏强 廖良生		
IPC分类号	H01L51/50 H01L51/52 H01L27/32		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a> <a href="#">SIPO</a>		

摘要(译)

本实用新型实施例提供一种OLED器件及像素结构。所述OLED器件包括发光单元、第一电极及第二电极。所述第一电极设置在所述发光单元的第一边缘，所述第二电极设置在所述发光单元的与所述第一边缘相对的第二边缘，以使所述OLED器件光线从所述第一电极和第二电极之间的发光单元发射出来。

